2P110

燐光 EL 発光特性を示す(C^N)Pt(O^O)型錯体の電子状態解析 (お茶の水女子大院・人間文化創成科学) ○田中美恵, 森寛敏

Electronic structure calculation of (C^N)Pt(O^O) type complexes for OLED (Ochanomizu Univ.) OMie Tanaka, Hirotoshi Mori

【序論】 燐光 EL 錯体は、ディスプレイ・照明材料への応用が期待される分子材料で ある。2010 年に大阪府立大学の中澄・八木らにより、配位子を変えることで発光色・ 発光寿命を調節できる燐光 EL、(C^N)Pt(O^O)錯体(図1)が報告された〔1〕。しか し、なぜ配位子を変えることで電子状態の調整が出来るのかは不明である。電子状態 調整のメカニズムを解明するためには、励起状態ダイナミクスに関わる電子構造を理 解することが必要である。電子構造を理解する手段の一つに吸収スペクトルがある。 紫外可視吸収スペクトルの観測は行われているが、理論的帰属はされていない。本研 究では、(C^N)Pt(O^O)錯体のスペクトル帰属を量子化学計算により行い、光化学に 関わる電子状態を解析した。

【計算方法】密度汎関数法及び時間依存密度汎関数法により、実験〔1〕で用いられたものと同じ(C^N)Pt(O^O)(C^N=a~fの6種を用いた。錯体および、C^N配位子の構造は図1参照。)錯体の S_0 、 S_1 、 T_1 について、構造最適化、振動数解析、NBO解析、励起スペクトル解析を行った。汎関数を数種用いて計算し、得られた結果をMP2法と比較して最適だと判断したLC-BLYPを汎関数に用いて議論した。基底関数はPtにSDD/MCP-tzp,その他に6-31G*を用いた。溶媒効果はPCM(溶媒はCHCl₃)で考慮した。



図 1: (C^N)Pt(O^O)錯体の構造式(左)と今回用いた 6 種の C^N 配位子(a~f)の構造(右)*R= dibutoxyphenyl

【結果と考察】実験〔1〕 で観測された吸収スペクトルと励起スペクトル解析により 理論的に求めた吸収スペクトルの結果を表1にまとめた。ピークが現れる相対的位置、 および 370nm 以下に現れる遷移のキャラクターも実験結果とよい一致を見せた。ま た、C^N 配位子が e,f の場合には、480-510nm の領域に ¹MLCT 遷移による吸収が現れ ると実験者らは述べている。しかし、励起スペクトル解析の結果、370nm より長波長 側にピークは見られておらず実験結果と矛盾する結果となった。そこで、基底状態か ら三重項励起状態への遷移が起こりうると仮定して励起スペクトル解析を行ったと ころ、450nm 付近に吸収が起こりえる励起状態があることがわかった(図 2)。した がって実験で ¹MLCT と帰属された吸収は ³MLCT である可能性が考えられた。この推 測を確かめるため、現在スピン軌道相互作用を考慮した計算を実施中である。 表 1:(C^N)Pt(O^O)(C^N=a~f)錯体の吸収スペクトルの吸収波長、吸収係数、振動子強度、遷移帰属

C^N	実験値*1	計算值*2	
	吸収波長 $\lambda_{max}[nm]$ ($\epsilon[M^{-1}cm^{-1}]$)遷移帰属 ^{*3})	吸収波長 $\lambda_{max}[nm]$ (f/遷移帰属 ^{*3})	
а	$238(4.39/\pi\text{-}\pi^*(C^{\Lambda}N)), 294(4.42/\pi\text{-}\pi^*(C^{\Lambda}N)),$	$194(0.21/\pi - \pi^*(C^{\Lambda}N))239(0.48/\pi - \pi^*(C^{\Lambda}N)),$	
	363(4.28/л-л*(О^О))	300(0.60/л-л*(О^О))	
b	$236(4.38/\pi-\pi^*(C^N)), 257(4.37/\pi-\pi^*(C^N)),$	$189(0.19/\pi-\pi^{*}(C^{N})),240(0.42/\pi-\pi^{*}(C^{N})),$	
	361(4.25/л-л*(О^О))	300(0.40/л-л*(О^О))	
с	$236(4.13/\pi$ - $\pi^*(C^N)),300(4.06/\pi$ - $\pi^*(C^N)),$	$184(0.24/\pi-\pi^*(C^N)), 247(0.55/\pi-\pi^*(C^N)),$	
	363(4.25/л-л*(О^О))	299(0.61/π-π [*] (O^O))	
d	$237(4.36/\pi-\pi^*(C^N)), 322(4.36/\pi-\pi^*(C^N)),$	$175(0.23/\pi-\pi^*(C^N)), 259(0.40/\pi-\pi^*(C^N)),$	
	371(4.30/л-л*(О^О))	300(0.76/π-π [*] (O^O))	
e	$237(4.33/\pi-\pi^*(C^N)),332(4.24/\pi-\pi^*(C^N)),$	$185(0.14/\pi-\pi^*(C^N)),277(0.40/\pi-\pi^*(C^N)),$	
	363(4.30/π-π [*] (O ^A O)),386(4.26/π-π [*] (O ^A O)),478(3.51/ ¹ MLCT)	300(0.77/л-л [*] (O^O))	
f	238(4.59/л-л [*] (C^N)),337(4.50/л-л [*] (C^N)),	193(0.7313/ILCT)270(0.27/π-π [*] (C^N)),	
	374(4.52/π-π [*] (O^O)),482(3.90/ ¹ MLCT),507(3.92/ ¹ MLCT)	300(0.72/л-л*(О^О))	

*1 紫外可視吸収スペクトル (CHCl₃溶媒中、298K で測定)

*2 TDDFT(LC-BLYP) (PCM で CHCl3の溶媒効果を考慮)

実験ではストークスシフトが観測されている。観測された吸収/発光波長の差をエネ ルギー差に直して実験値と計算値を比較すると(表 2)、実験値よりも計算値ではエ ネルギー差を 0.10~0.25eV 程度過小評価したものの、実験と計算で良い対応を得るこ とができた。唯一 C^N=f の場合だけ、実験値より計算値が 0.5 eV 以上過小評価され た結果が得られているが、この原因として、C^N=f の場合スピン軌道相互作用の影響 が大きい可能性を考え、現在検討中である。詳細は当日報告する。



表 2: (C^N)Pt(O^O)錯体 (C^N=a~f) のストークスシフト

のい可たての話符	ストークスシフト (eV)	
C^N 配位于の種類	計算値	実験値
а	0.92	1.02
b	0.88~1.21*	1.04
с	1.06	1.20
d	1.07	1.32
e	1.06	1.33
f	1.01	1.56



*大振幅振動を考慮

(1) J.lumin 130 (2010)217-221 Shigeyuki Yagi, Hiroyuki Nakazumi et al